モデルニューロンにおける Ca²⁺振動

北嶋 龍雄 ○澤井 有紀 久保貴嗣 (山形大学)

Ca²⁺ oscillations in a model neuron

T. kitagima, *Y. Sawai, and T. Kubo (Yamagata University)

Abstruct: Intracellular Ca²⁺ plays an important role in many cell functions. A number of cells respond to a hormonal stimulus with a periodic oscillation in intracellular Ca²⁺. Properties of oscillations depend on Ca²⁺-dependent activation of inositol 1,4,5-triphosphate receptors on the endoplasmic reticulum membrane. By using a computer simulation based on one simple neuron model with endoplasmic reticulum, we show Ca²⁺-dependent positive-feedback interaction in IP3 receptors that result in an intracellular Ca²⁺ oscillation. A contribution of Ca²⁺-dependent IP3 production process to an Ca²⁺ oscillation is also considered.

key words: IP3 receptor, phospholipase C, Ca oscillation, Endoplasmic Reticulum

1. まえがき

神経細胞内のCa²⁺振動現象は神経細胞で行われているさまざまな情報処理機能の基礎過程として重要な役割をもつと考えられている。とくに、細胞内小胞体膜上に存在する IP3(inositol 1,4,5 trisphosphate,イノシトール三リン酸)受容体を介して細胞質内のCa²⁺振動が生じることが明らかにされている。しかし、そのようなCa²⁺振動が情報処理機能にどのような関わりをもっているかは明らかでなく、その特性を調べる事は学習・記憶といった脳の高度な情報処理機能を解明するための手がかりを得る意味でも重要な問題である。

先に、Tangやde Young らは、細胞内小胞体膜上に存在する IP3 受容体による Ca 振動特性を明らかにするために、IP3 一定のもとで Ca²+振動現象を示すモデルを示した 1)233。しかし、細胞質内の IP3 濃度は細胞外刺激入力および、細胞質内 Ca²+濃度によっても変化することが知られている。ここでは外部刺激入力による IP3 の産生及び Ca²+依存性 IP3 産生機構を組みこんだニューロンモデルを構築し、それらの機構が細胞質内 Ca²+振

動特性とどのような関わりをもっているのかを計 算機シミュレーションにより明らかにする。

2. IP3 受容体開口機序と細胞質内 Ca²⁺振動

前シナプス部から放出された伝達物質が後シナ プス膜上の代謝調節型受容体と結合してPLC (フ ォスフォリパーゼ C) が活性化されるとき、PIP₂ (フォスファチジルイノシトール二リン酸) から IP3 が産生される。このとき、水溶性の IP3 は細 胞質内を移動し、小胞体膜上の IP3 受容体と結合 する。活性化された IP3 受容体を介して、小胞体 内から細胞質内へ Ca²⁺が放出される。 Bezprozvanny らはIP3 受容体の開口確率はCa²⁺ 濃度に依存しベル型となることを示した[図 1]4。 すなわち、細胞質内の Ca2+濃度が上昇するにつ れてIP3 受容体の開口確率が大きくなるが、さら にCa²⁺濃度が上昇すると逆に開口確率は減少する ことを示している。このような IP3 受容体へのフ ィードバック抑制機構と後シナプス膜および小胞 体膜上の双方に存在するCa²⁺排出ポンプにより細 胞質内 Ca²⁺濃度は減少する。一方、PLC は、Ca²⁺ 濃度に依存して活性が上昇するために、再び IP3 の産生が促進され、IP3 受容体の開口確率が上昇する。このような機序によって、細胞質内の Ca²⁺ 振動が生じると考えられる。以上のべた IP3 受容体の開口機序を図2に示す。

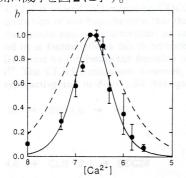


図 1 IP3 受容体開口特性 (Bezprozvanny et al,1991)

3.モデル化

3.1 ニューロンモデル

本研究で用いるニューロンモデルを図3に示す。 後シナプス部膜上には前シナプス部から放出され る神経伝達物質と結合するいくつかの受容体が存 在する。例えばグルタミン酸の受容体としては AMPA型、NMDA型、ACPD型受容体が知られ ている。AMPA型、NMDA型受容体は後シナプ ス膜電位の生成とその結果生じる膜電位依存性 Ca²⁺の流入に関わっている。一方、ACPD型受容 体は代謝調節型受容体(mGluR)とよばれ、Gタン パク質を介した PLC の活性化により IP3 の産生 に関わっている。本研究では前シナプス部からの 伝達物質放出による外部刺激入力に対して IP3 が産生されると考えるために、後シナ プス膜上には代謝調節型受容体のみが存在する ものとする。細胞内には小胞体(Endoplasmic Reticulum)が存在し、小胞体膜上にはIP3 受容体 が存在する。さらに、後シナプス部膜上には細胞 質内の Ca²⁺を細胞外に排出するための Ca ポンプ および小胞体内へCa2+を取り込む Ca ポンプ が存在するものとする。

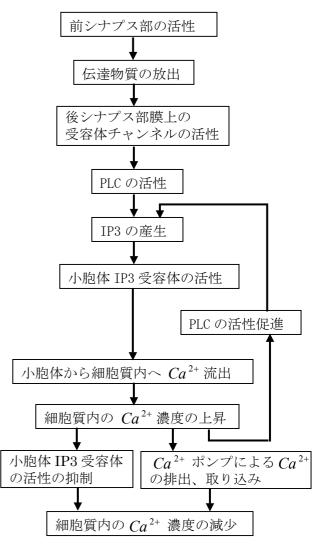


図2 IP3 受容体の開口機序

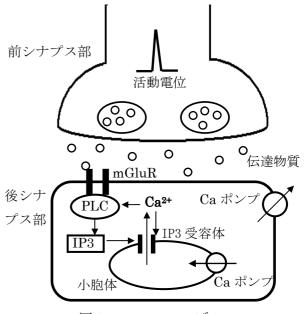


図 3 ニューロンモデル

3.2 IP3 の産出モデル

2節で述べたように、IP3はPLCの活性化により産出される。PLCは代謝調節型受容体に伝達物質が結合すると活性化される。またPLCは細胞質内のCa²⁺濃度に依存して活性されるので、ここでは両者の和でPLCの活性をモデル化する。

[PLC] =
$$u_1 * m(t) + u_2 * \frac{q_1 * C^2}{C^2 + q_2^2}$$
 (1)

C は細胞質内の Ca²⁺濃度をあらわす。右辺第一項 m(t)は代謝調節型受容体の活性、一方、第二項は 細胞質内 Ca²⁺濃度依存性を表す。u₁、u₂、g₁、g₂ は定数である。

IP3の産生はPLC活性によってPIP2から産生されるが、ここでは簡単のために、(1)式で表される PLC 活性に比例して IP3が産生されるものとする。

$$[IP3] = k[PLC]$$
 (2)

ここで k は比例定数である

3.3 IP3受容体活性機構のモデル

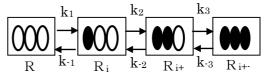
IP3 受容体は四量体で構成されており、そのうち三個がCa²+放出機構に関与していると考えられている。すなわち、IP3 受容体にはIP3 結合部位、Ca²+活性結合部位、およびCa²+不活性結合部位が存在し、IP3 受容体が開口するためには、IP3 がIP3 結合部位と結合し、Ca²+が Ca²+活性結合部位と結合することが必要である。もし Ca²+が Ca²+ 不活性結合部位と結合する場合は、IP3 受容体は逆に閉口する。以上の反応機構の模式図を図4に示す。

 k_1 、 k_2 、 k_3 はそれぞれ IP3 受容体と IP3 の結合 速度定数、 Ca^{2+} の活性結合定数、 Ca^{2+} の不活性結 合定数で、 k_1 、 k_2 、 k_3 はそれぞれ IP3、 Ca^{2+} の解 離速度定数を表す。

4. シミュレーション

IP3はPLCの活性化および細胞質内のCa2+濃

度の両者の和で PLC の活性が生じるものとしているが、Ca²⁺濃度依存性産生機構がない場合とある場合について、細胞質内 Ca²⁺振動特性へ与える影響を調べる。シミュレーションで用いたパラメータを表1に示す。



ABO

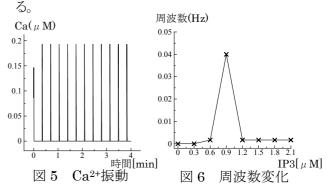
A: IP3 結合部位

B: Ca 結合部位(活性) C: Ca 結合部位(不活性)

図 4 IP3 受容体の活性機構の模式図

4.1 Ca2+濃度依存性産生機構がない場合

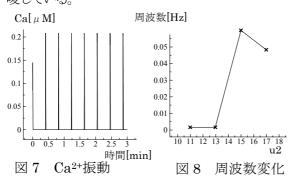
 $IP 3 = 0.5 \mu M$ [一定] としたときにえられた細胞質内 Ca^2 振動を図 5 に示す。約 0.04Hz の振動現象が見られる。さらに、IP 3濃度を $0 \mu M$ から $2.2 \mu M$ まで変化させたときの Ca^2 振動周波数の変化を図 6 に示す。 $IP 3 = 0.9 \mu M$ で周波数は最大となるが、IP 3濃度が $1.2 \mu M$ を超えると Ca^2 振動現象は見られなくなる。これは IP 3濃度を大きくすると IP 3受容体の活性が飽和し、 Ca^2 ポンプによる Ca^2 の排出がバランスをとって Ca^2 濃度が一定となってしまうために生じると考えられ



4.2 Ca²⁺濃度依存性産生機構がある場合

IP 3濃度が最大周波数を取る 0.9μ M に固定とし(1)式の係数 u_2 =15 としたときにえられた細胞質内 Ca^{2+} 振動を図 7 に示す。約 0.05Hz の振動現象が見られ、 Ca^{2+} 濃度依存性産生機構がない場合

より大きい周波数となる。このとき、係数 w2の値を10から17まで変化させたときの Ca²⁺振動周波数の変化を図8に示す。係数 w2の値が13以下の場合には IP3の産生への Ca²⁺濃度の影響が見られないことがわかる。このことは、外部刺激入力の大きさと Ca²⁺濃度依存性産生のバランスが細胞質内の Ca²⁺振動現象に重要な役割を持つことを示唆している。



5. あとがき

IP 3 受容体を持つ小胞体を含むニューロンモデルを用いたシミュレーションにより、細胞質内の Ca²⁺振動現象には外部刺激入力の大きさと Ca²⁺濃度依存の IP 3 産生が相互に関係することを明らかにした。細胞質内へは後シナプス部膜内に存在する膜電位依存性 Ca²⁺チャネルおよび NMDA 受容体チャネルを通しても Ca²⁺が流入することから、これらを組み込んだモデルを用いて、前シナプス部の活性パターンと後シナプス部細胞質内 Ca²⁺振動現象を明らかしていく必要がある。

6.参考文献

1)Tang,Y.&Othmer,H.G.: Frequency encoding in excitable systems with applications to calcium oscillations, Proc.Natl.Acad.Sci.USA.Vol.92.7869-7873.1995

2) Tang, Y.&Othmer, H.G.: A Model of Calcium Dynamics in Cardiac Myocytes Based on the Kinetics of Ryanodine-Sensitive Calcium Channels , Biophysical Jornal Vol. 67 2223-2235 1994

3)De Young,G,W.&Keizer,J: A single-pool inositol1,4,5 -trisphosphate-receptor-based model for agoniststimulated oscillations in Ca²⁺ concentration, Proc.Natl. Acad.Sci.USA.Vol.89,9895-9899,1992

4)Bezprozvanny,L.,Watras,J.&Ehrlich,B.E.: Bell-shaped calcium-response curves of Ins(1,4,5)P₃ and calcium-gated channels from endoplasmic reticulum of cerebellum, NATURE,Vol351,751-753,1991

Apendix

$$\frac{dR}{dt} = -k_1 * I * R + k_{-1} * R_i$$
 (3)

$$\frac{dR_i}{dt} = -(k_{-1} + k_2 * C) * R_I + k_1 * I * R + k_{-2} * R_{i+}$$
 (4)

$$\frac{dR_{i+}}{dt} = -(k_{-2} + k_3 * C) * R_{i+} + k_2 * C * R_i + k_{-3} * R_{i+-} (5)$$

$$\frac{dR_{i+-}}{dt} = k_3 * C * R_{i+} - k_{-3} * R_{i+-}$$
 (6)

ただしCは細胞質内Ca²⁺濃度を表しその濃度変化は 以下のダイナミクスで表される。

$$\frac{dC}{dt} = Vr * g_1 * ([C]_e - C) + g_2 * (C_0 - C) - \frac{q_1 * C^2}{C^2 + q_2^2} + Vr * \left\{ ch * R_{i+-} * ([C]_e - C) - \frac{p_1 * C^2}{C^2 + p_2^2} \right\}$$
(7)

(Coは細胞外 Ca²⁺濃度、[C]e 小胞体内 Ca²⁺濃度)

Vr	0. 185	Vr	0. 185
k_1	120.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$	k_1	120.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
k	150.0 $\mu \mathrm{M}^{1} \cdot \mathrm{s}^{1}$	k	150.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
k_3	0.18 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$	k_3	0.18 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
k_{-1}	96.0 s^{-1}	k_{-1}	96. 0 s ⁻¹
k_{-2}	29.4 s ⁻¹	k_{-2}	18.0 s ⁻¹
k_{-3}	0.018 s^{-1}	k_{-3}	0.018 s^{-1}
ch	80.0 s ⁻¹	ch	80.0 s ⁻¹
p_1	54.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$	p_1	54.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
p_2	0.012 μ M	p_2	0.03 μ M
	0.025 s^{-1}	g_1	0.025 s^{-1}
g_2	$0.4 s^{-1}$	g_2	36. 0 s^{-1}
[C] _e	1.56 μ M	[C] _e	1.56 μ M
\mathbf{q}_1	50.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$	\mathbf{q}_1	19.0 $\mu \mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
q_2	0.02 μ M	\mathbf{q}_2	$0.02 \mu M$
u_1	1.0	u_1	1.0
u_2	0.0	u_2	19. 0
C_0	1500 mM	C_0	1500 mM

表1 シミュレーションで用いたパラメータ